

# 表面P(リン)汚染の除去効果評価



## ＜分析手法＞SIMS(二次イオン質量分析)による P(リン)の深さ方向分析

表面汚染はその後の熱工程で基板内部に拡散し、特性に悪影響を与えます。表面洗浄方法が異なる試料(Si基板)について、熱処理後にPの深さ方向分布を比較しました。

### ＜結果＞

洗浄方法により基板内部に拡散するPの量が異なり、処理3がP除去に特に有効であることが分かりました。

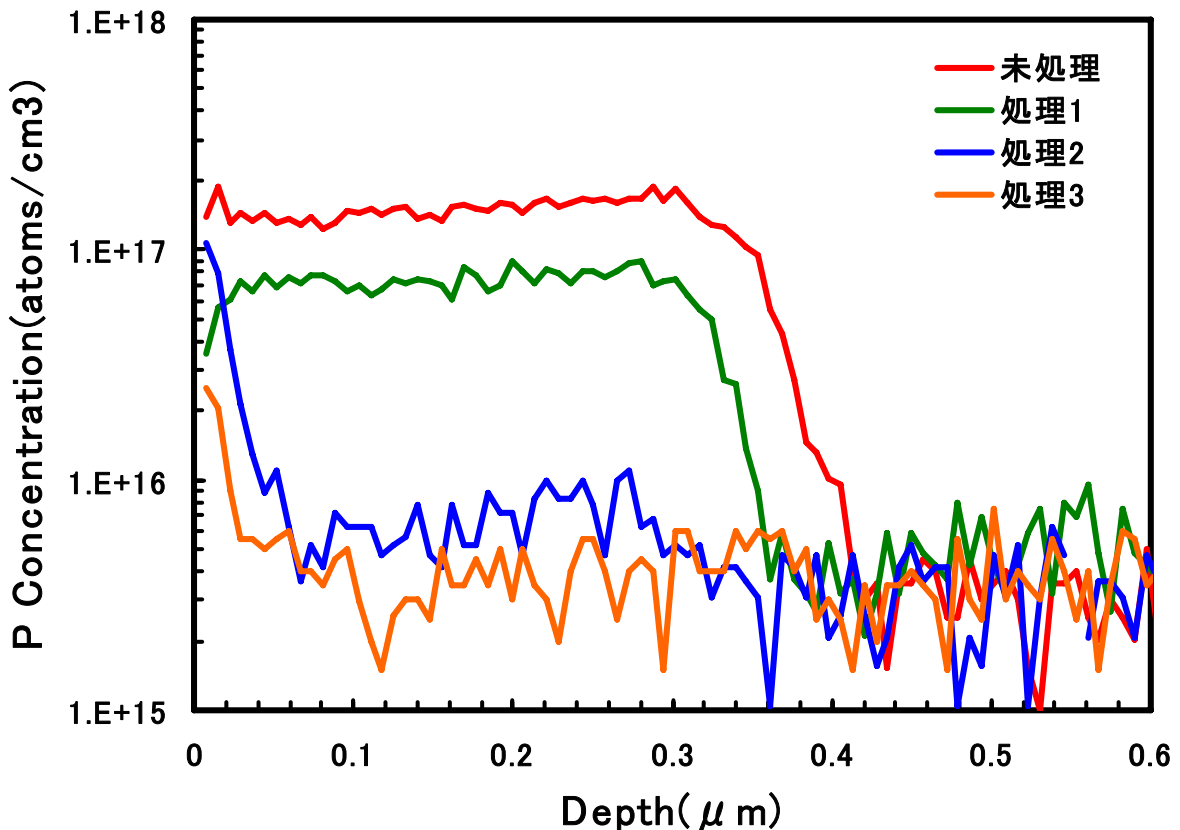


図 P(リン)の深さ方向分布